

氏名(国籍)	ムハマド ナルシ カン (パキスタン)		
学位の種類	博士(工学)		
学位記番号	博甲第1,883号		
学位授与年月日	平成10年3月23日		
学位授与の要件	学位規則第4条第1項該当		
審査研究科	工学研究科		
学位論文題目	Synthesis and Transport Properties in Nb Doped Hexagonal Barium Titanate (Nbドーピングされた六方晶チタン酸バリウムの合成と輸送特性)		
主査	筑波大学教授	理学博士	植寛素
副査	筑波大学教授	理学博士	大嶋建一
副査	筑波大学教授	工学博士	瀧田宏樹
副査	筑波大学助教授	理学博士	小島誠治
副査	筑波大学教授	博士(理学)	南英俊

論文の内容の要旨

第2種変位型構造相転移を示す六方晶 BaTiO_3 に Nb をドーピングして金属にした系を対象に、その合成法と金属半導体転移が調べられている。

固相反応法によるセラミック、レーザーアブレーション法による薄膜、赤外線集中法による単結晶の試料が合成されている。電子線顕微分析、エックス線回折、ラザフォード後方散乱の手法により試料の分析を行っている。セラミック試料は粒界の影響のため電気伝導特性の評価には向かないことがわかった。赤外線集中法による単結晶については Ti サイトを Nb で置換して金属的伝導を示す試料を作ることができた。薄膜はサファイヤ基板上にエピタキシャル成長させることが出来たが、双晶構造を有することがわかった。

これらの試料を対象にして電気抵抗の温度変化、熱起電力の温度変化、帯磁率の温度変化が調べられた。金属的伝導を示す試料は、温度が下降して第2種の変位型構造相転移が生じると半導体型の電気伝導特性に変化し Nb で置換した試料は可変領域ホッピング伝導の特性を示した。酸素欠損を有する試料も金属半導体転移を示すが最近接不純物間ホッピング伝導の特性を示す。可変領域ホッピング伝導の特性を解析することにより、電子の局在長を評価することができ、局在長は第2種の構造相転移温度に向かい増大することが示された。抵抗値は金属半導体の転移温度で温度係数は反転するものの連続的に変化し飛びを示さない。第2種の構造相転移の原子変位により伝導帯のバンド幅が狭くなり局在が生じると議論されている。

審査の結果の要旨

試料作製の面では多様な方法に取り組み、それぞれの方法で一応の合成に成功しているのは評価される。金属半導体転移について可変領域ホッピングを見だし、これにより局在長を評価できたことにより、第2種の構造相転移温度に向かい局在長の増大を発見した。これは金属半導体転移について初めて見いだされた現象で物理的に興味深く評価される。

よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。